09 Коэффициент усиления сетчатых рефлекторных параболических антенн произвольной глубины

© В.П. Акимов, С.Б. Глыбовский, В.К. Дубрович

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Научный центр прикладной электродинамики, Санкт-Петербург E-mail: sgbs@mail.ru

Поступило в Редакцию 3 октября 2012 г.

Получены аналитические выражения, позволяющие рассчитать коэффициент усиления сетчатого параболического зеркала при произвольном соотношении фокусного расстояния и диаметра апертуры. Результаты получены для случая густой тонкопроволочной сетки с квадратными ячейками и идеальными контактами проводников в узлах с помощью метода усредненных граничных условий. Показаны особенности влияния "сетчатости" на усиление зеркал различной глубины.

В технике зеркальных антенн часто используются металлические сетки в качестве материала рефлектора, что имеет целый ряд эксплуатационных преимуществ по сравнению со сплошными зеркалами. Для плоских сеток с различными топологиями проводников задача расчета отражательных свойств была решена методом усредненных граничных условий Конторовича [1] и получены коэффициенты отражения падающей плоской электромагнитной волны (ЭМВ). Данные результаты применялись затем и для расчета направленных свойств сетчатого параболического зеркала в приближении постоянного поверхностного импеданса методом интегральных уравнений, а также с использованием коэффициентов отражения методом физической оптики [2]. Однако при этом предполагалось, что отражательные свойства сетки можно считать одинаковыми в разных точках зеркала, что справедливо, строго говоря, лишь для рефлекторов с большим отношением фокусного расстояния F к диаметру апертуры D.

В данной статье решается задача о влиянии "сетчатости" на коэффициент усиления параболического зеркала с произвольным соотношением *F* и *D* в аналитической форме. За основу взяты результаты, получен-

61



Рис. 1. Постановка задачи и выбранная система координат.

ные авторами при расчете корректирующего сетчатого рефлектора для неровного параболического зеркала [3]. Постановка задачи показана на рис. 1. Центр сферической системы координат (R, ϑ, φ) выбран в фокусе параболоида с фокусным расстоянием F, причем ось OZ ориентирована в направлении вершины параболоида. Поверхность параболоида описывается уравнением $R = 2F/(1 + \cos \vartheta)$, причем для точек на краю апертуры диаметром D угол ϑ_{max} , который составляет радиус-вектор с осью OZ, такой, что $\cos(\vartheta_{\text{max}}/2) = (1 + D^2/16F^2)^{-1/2} = C$. Рассматривается осевое падение плоской ЭВМ с длиной λ и амплитудой \vec{E}_0 , поляризованной вдоль оси OX.

В соответствии с принципом Гюйгенса—Киргхофа дифракционное поле \vec{E}^{S} в фокусе параболоида может быть найдено в форме интеграла по поверхности *S* параболоида [4]:

$$\vec{E}^{S}\vec{a} = \int_{S} \left\{ \left[\vec{n} \times \vec{H}_{\tau} \right] \vec{E}^{D} + \left[\vec{n} \times \vec{E}_{\tau} \right] \vec{H}^{D} \right\} dS, \tag{1}$$

где \vec{E}_{τ} и \vec{H}_{τ} — полные касательные составляющие электрического и магнитного полей; \vec{n} — внешняя нормаль, \vec{E}^D и \vec{H}^D — электрическое и магнитное поля в точке интегрирования электрического диполя с моментом \vec{a} , расположенного в фокусе.

Будем считать, что сетка параболоида имеет квадратную ячейку и идеальные электрические контакты проводников в узлах. Кроме того, она является достаточно плотной, а проводники проводимостью σ_i и

магнитной проницаемостью μ_i — достаточно тонкими: $r_0 \ll \alpha$, $\alpha \ll \lambda$, где r_0 — радиус проводника, α — период сетки. Также предполагается, что D и F многократно превышают λ . В силу указанных предположений можно с достаточной степенью точности считать форму ячейки сетки на параболической поверхности квадратной. Считая радиус кривизны поверхности много большим длины волны, воспользуемся приближением физической оптики. Полное поле на поверхности \vec{E}_{τ} в (1) можно выразить с помощью коффициентов отражения от плоской сетки в виде

$$\vec{E}_{\tau} = \left[\vec{\tau}^{H} E_{0}^{H}(1+R^{HH}) + \vec{\tau}^{E} E_{0}^{E}(1-R^{EE})\right] \exp(-ikz),$$
(2)

где $k = 2\pi/\lambda$ — волновое число; z — вертикальная координата точки интегрирования; $\vec{\tau}^E$, $\vec{\tau}^H$ — касательные составляющие ортов, задающих направление электрического поля E- и H-поляризованных компонент падающей волны, а E_0^E , E_0^H — соответствующие значения комплексных амплитуд. Аналогичную формулу можно получить и для \vec{H}_{τ} . Так как локальный угол падения волны равен $\vartheta/2$, то входящие в (2) коэффициенты отражения равны [1]:

$$R^{E} = \frac{\cos(\vartheta/2)}{\cos(\vartheta/2) + i\kappa[1 + \Psi - 0.5\sin^{2}(\vartheta/2)]};$$
$$R^{H} = \frac{-1}{1 + i\kappa\cos(\vartheta/2)(1 + \Psi)},$$
(3)

где $\kappa = \frac{2\alpha}{\lambda} \ln \left(\frac{\alpha}{2\pi r_0}\right)$ — параметр сетки, а величина Ψ учитывает скинэффект:

$$\begin{split} \Psi &= \Psi_1 + i\Psi_2 \\ &= -\frac{\mu_i}{\ln(\alpha/2\pi r_0)} \frac{(1-i)}{r_0} \sqrt{\frac{1}{2\omega\mu_0\mu_i\sigma_i}} \frac{J_0[r_0(1-i)\sqrt{\omega\mu_0\mu_i\sigma_i/2}]}{J_1[r_0(1-i)\sqrt{\omega\mu_0\mu_i\sigma_i/2}]} \end{split}$$

где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m; $\omega = 2\pi f$ — круговая частота; $J_m(x)$ — функция Бесселя порядка *m*.

После подстановки (3) с учетом (2), а также выражений для \vec{E}^D , \vec{H}^D , E_0^E , E_0^H , $\vec{\tau}^E$ и $\vec{\tau}^H$, записанных в выбранной системе координат в (1), можно перейти к однократному интегралу по углу ϑ в пределах от 0 до ϑ_{max} . Затем, испольузя замену $\xi = \cos(\vartheta/2)$, можно получить

выражение для х-компоненты электрического поля в фокусе:

$$E_x^S = -2ikFE_0(2I_1 + I_2)$$

= $-2ikFE_0 \left\{ 2 \int_{1}^{C} \frac{(2\xi^2 - 1)d\xi}{2\xi + i\kappa(1 + 2\Psi + \xi^2)} + \int_{1}^{C} \frac{d\xi}{\xi[1 + i\kappa\xi(1 + \Psi)]} \right\}.$ (4)

Путем выделения вещественной и мнимой частей подынтегральных функций (4) и разложения полученных слагаемых на рациональные дроби выражения для слагаемых I_1 и I_2 могут быть получены после интегрирования в замкнутой форме:

$$\begin{split} I_{1} &= \frac{-i}{\kappa} \Biggl\{ 2C - 2 - \frac{K_{1}}{2} \ln \Biggl[\frac{(C - v_{1}/\sqrt{2})^{2} + \beta_{1}^{2}}{(1 - v_{1}/\sqrt{2})^{2} + \beta_{1}^{2}} \Biggr] - iK_{1} \Biggl[\arctan\left(\frac{C - v_{1}/\sqrt{2}}{\beta_{1}} \right) \\ &- \arctan\left(\frac{1 - v_{1}/\sqrt{2}}{\beta_{1}} \right) \Biggr] - \frac{K_{2}}{2} \ln \Biggl[\frac{(C + v_{1}/\sqrt{2})^{2} + \beta_{2}^{2}}{(1 + v_{1}/\sqrt{2})^{2} + \beta_{2}^{2}} \Biggr] \\ &- iK_{2} \Biggl[\arctan\left(\frac{C + v_{1}/\sqrt{2}}{\beta_{2}} \right) - \operatorname{arctg}\left(\frac{1 + v_{1}/\sqrt{2}}{\beta_{2}} \right) \Biggr] \Biggr\}; \\ I_{2} &= \ln C - \frac{i(1 + \Psi)}{2[\Psi_{2} - i(1 + \Psi_{1})]} \Biggl[-2i \Biggl(\operatorname{arctg} \frac{[\Psi_{2}^{2} + (1 + \Psi_{1})^{2}]C\kappa - \Psi_{2}}{1 + \Psi_{1}} \\ &- \operatorname{arctg} \frac{[\Psi_{2}^{2} + (1 + \Psi_{1})^{2}]\kappa - \Psi_{2}}{1 + \Psi_{1}} \Biggr) - \ln \frac{\kappa^{2}C^{2}[\Psi_{2}^{2} + (1 + \Psi_{1})^{2}] - 2\kappa\Psi_{2}C + 1}{\kappa^{2}[\Psi_{2}^{2} + (1 + \Psi_{1})^{2}] - 2\kappa\Psi_{2}C + 1} \Biggr], \end{split}$$
(5)

где коэффициенты K₁ и K₂ рассчитываются по следующим формулам:

$$K_1 = -\frac{4i}{\kappa} - K_2;$$

$$K_2 = \frac{-1}{\sqrt{2}} \frac{3 + 4\Psi_1 + 4\kappa^{-2} - 2\sqrt{2}v_2\kappa^{-1} + i(4\Psi_2 + 2\sqrt{2})v_1\kappa^{-1}}{v_1 + iv_2},$$

а выражения для остальных задействованных величин приведены ниже:

$$\beta_1 = \kappa^{-1} + v_2/\sqrt{2}; \quad \beta_2 = \kappa^{-1} - v_2/\sqrt{2};$$
$$v_{1,2} = \sqrt{\sqrt{(\kappa^{-2} + 1 + 2\Psi_1)^2 + 2\Psi_2^2}} \mp (\kappa^{-2} + 1 + 2\Psi_1).$$

Далее с помощью полученного выражения (4) для E_x^S определяется коэффициент использования площади апертуры (КИП) ν , равный отношению коэффициента усиления (КУ) антенны с сетчатым зеркалом G^{solid} . Предполагается, что уровень принимаемого сигнала в каждом случае пропорционален уровню *x*-компоненты поля в фокусе. Тогда КИП можно определить как $\nu = |E_x^{S mesh}/E_x^{S solid}|^2$, где $E_x^{S mesh}$ рассчитывается по формулам (4)–(5), в то время как поле $E_x^{S solid}$ может быть найдено посредством предельного перехода $\kappa \to 0$ в формуле (4). Полученный таким образом интеграл легко вычисляется, что приводит к следующему выражению для КИП:

$$\nu = \frac{|2I_1 + I_2|^2}{(C^2 - 1)^2}.$$
(6)

При отсутствии омических потерь в проводниках сетки $\Psi = 0$, и выражение для КИП существенно упрощается:

$$\nu = \frac{1}{(C^{2} - 1)^{2}} \Biggl\{ \Biggl[\frac{1}{\kappa} \left(\frac{3\kappa + 4\gamma_{1}}{2\sqrt{\kappa^{2} + 1}} \ln \frac{C^{2} + \gamma_{1}^{2}}{1 + \gamma_{1}^{2}} - \frac{3\kappa - 4\gamma_{2}}{2\sqrt{\kappa^{2} + 1}} \ln \frac{C^{2} + \gamma_{2}^{2}}{1 + \gamma_{2}^{2}} \Biggr) + \ln C - \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \kappa^{2}C^{2}}{1 + \kappa^{2}} \Biggr]^{2} + \Biggl[\frac{2}{\kappa} \left(2C - 2 + \frac{3\kappa + 4\gamma_{1}}{2\sqrt{\kappa^{2} + 1}} \left(\arctan \frac{1}{\gamma_{1}} - \arctan \frac{C}{\gamma_{1}} \right) \right) + \frac{3\kappa - 4\gamma_{2}}{2\sqrt{\kappa^{2} + 1}} \left(\arctan \frac{C}{\gamma_{2}} - \operatorname{arctg} \frac{C}{\gamma_{2}} \right) + \operatorname{arctg}(C\kappa) - \operatorname{arctg} \kappa \Biggr]^{2} \Biggr\}, \quad (7)$$

где $\gamma_{1,2} = (\sqrt{\kappa^2 + 1 \pm 1})/\kappa.$

. -

Таким образом, учет "сетчатости" произвольного параболического зеркала может быть осуществлен умножением КУ соответствующего сплошного зеркала на величину КИП, рассчитываемую по формулам (6), (7). На рис. 2 приведено семейство зависимостей КИП от соотношения F/D для сеток различной плотности. Заметим, что КИП зависит только от соотношения F и D, в то время как КУ пропорционален квадрату F, либо D. Кривые, проведенные жирной линией на рис. 2, a, представлены для $r_0/\alpha = 0.1$, и трех значений α/λ для частоты 300 GHz, $\sigma_i = 11.5$ MS/m. Также на рис. 2, a представлены тонкие горизонтальные прямые линии, соответствующие приближению,



Рис. 2. Зависимости КИП от F/D при $r_0/\alpha = 0.1$ (*a*), $r_0/\alpha = 0.05$ (*b*).

сделанному в [2], и рассчитанные по следующей формуле:

$$\nu \approx |R^E(0)|^2 = |R^H(0)|^2.$$
 (8)

На рис. 2, *b* приведены аналогичные характеристики, но для случая $r_0/\gamma = 0.05$.

Из графиков, представленных на рис. 2, видно, что КИП, вносимый за счет замены металлического зеркала сетчатым, рассчитанный по полученным формулам (4), (5), зависит от F/D и заметно отличается от найденного по формуле (8) уже в диапазоне $F = (0.25 \div 1)D$. Для мелких зеркал ($F/D \gg 1$) отражение в каждой точке поверхности параболоида происходит практически под одним и тем же углом, близким к нулю. Поэтому КУ сетчатого зеркала оказывается

пропорциональным квадрату модуля коэффициента отражения сетки для нормального падения. В результате происходит снижение КУ по сравнению со сплошным зеркалом (v < 1). Для глубоких же зеркал области, далекие от центра параболоида, отражают падающую волну в фазе, если близки к плоскости поляризации (XOZ), и в противофазе, если они близки к ортогональной плоскости (YOZ). Таким образом, области, равноудаленные от центра параболоида, могут отражать волну с фазой, отличающейся на π из-за различия в типе поляризации. Этот эффект, присущий сплошному металлическому зеркалу, снижает КУ с уменьшением фокусного расстояния при постоянном диаметре апертуры из-за перехода энергии падающей волны в кросс-поляризованную составляющую поля. С другой стороны, тонкопроволочная сетка при падении волны под скользящим углом имеет коэффициент отражения по *Н*-поляризации, близкий к –1 (как и сплошное зеркало), но в случае Е-поляризации падающей волны становится почти прозрачной. Поэтому часть зеркала начинает пропускать падающее излучение, вместо того чтобы создавать противофазную отраженную волну. В итоге, несмотря на потерю мощности за счет пропускания Е-поляризации, КУ сетчатого зеркала может оказаться выше, чем в случае сплошного за счет отсутствия противофазных отраженных волн. Сказанное иллюстрируется кривыми на рис. 2, где $\nu > 1$ при $F/D \ll 1$.

Заметим в заключение, что результаты данной работы справедливы для параболических антенн с облучателем в виде точечного диполя. Однако принцип повышения КУ глубокого зеркала при переходе от сплошной отражающей поверхности к сетчатой действует для произвольного линейно-поляризованного облучателя, значительно не превышающего по размерам фокальное пятно.

Список литературы

- [1] Конторович М.И., Астрахан М.И., Акимов В.П., Ферсман Г.А. Электродинамика сетчатых структур. М.: Радио и связь, 1987. 135 с.
- [2] David C. Jenn, Prata A.Jr., Willard V.T. Rusch, Barclay M.R. // IEEE Trans. on Antennas and Propagation. 1989. V. 37. N 11. P. 1484–1486.
- [3] Акимов В.П., Глыбовский С.Б., Дубрович В.К. // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Информатика, телекоммуникации, управление. 2011. № 3(126). С. 52–61.
- [4] *Каценеленбаум Б.3.* Высокочастотная электродинамика. М.: Наука, 1966. 240 с.